



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФНИЦ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» РАН)

06.08.2020

П Р И К А З

№ 81

Москва

О создании
апелляционных комиссий при
проведении государственной
итоговой аттестации аспирантов в 2020 году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (ред. от 5 апреля 2016 г.), Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Сформировать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций результатов государственных аттестационных испытаний в 2020 году во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия в следующем составе:

Председатель комиссии: Алексеева О.А., директор.

Члены комиссии:

- Голубева А.С., к.ф.-м.н., заместитель директора по научно-организационной деятельности ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;

- Иванова Е.С., к.ф.-м.н., ученый секретарь структурного подразделения ИК РАН;
- Авилов А.С., д.ф.-м.н., главный научный сотрудник сектора электронной дифрактометрии структурного подразделения ИК РАН;
- Муслимов А.Э., д.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории роста тонких пленок и неорганических наноструктур структурного подразделения ИК РАН.

2. Сформировать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций результатов государственных аттестационных испытаний в 2020 году во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи, в следующем составе:

Председатель комиссии: Шкуринов А.П., руководитель ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

Члены комиссии:

- Лотин А.А., к.ф.-м.н., заместитель руководителя по научной работе ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;
- Низьев В.Г., д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник НОЦ «Лазеры, оптика, информатика» ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;
- Попов В.К., д.ф.-м.н., главный научный сотрудник лаборатории сверхкритических флюидных технологий структурного подразделения ИФТ РАН.

3. Начальнику отдела образовательных программ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Имамовой Л.Р. довести настоящий приказ до всех членов апелляционной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по научно-организационной деятельности ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Голубеву А.С.

Директор



Алексеева О.А.